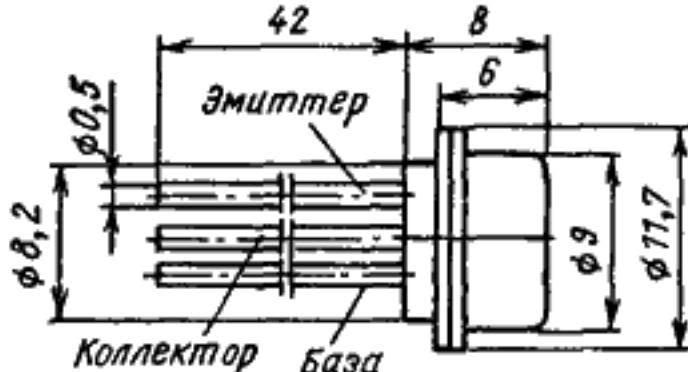


**2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И,
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д,
КТ603Е**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* импульсные высокочастотные маломощные

Предназначены для применения в импульсных и переключательных высокочастотных схемах



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер

при $I_K = 150 \text{ mA}$, $I_B = 15 \text{ mA}$:

2T603A, 2T603Б, 2T603В, 2T603Г не более	0,8 В
типовое значение	0,2* В
KT603A, KT603Б, KT603В, KT603Г, KT603Д, KT603Е не более	1,0 В
при $I_K = 350 \text{ mA}$, $I_B = 50 \text{ mA}$ 2T603И не более	1,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер:

при $I_K = 150 \text{ mA}$, $I_B = 15 \text{ mA}$:

2T603A, 2T603Б, 2T603В, 2T603Г, KT603A, KT603Б, KT603В, KT603Г, KT603Д, KT603Е не более	1,5 В
типовое значение	0,9* В
при $I_K = 350 \text{ mA}$, $I_B = 50 \text{ mA}$ 2T603И не более	1,3 В
типовое значение	1,0* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 2 \text{ В}$

при $T = 298 \text{ K}$:

при $I_E = 150 \text{ mA}$.

2T603A, 2T603Б, KT603Д	20 – 80
KT603A, KT603В	10 – 80
2T603Б, 2T603Г	60 – 180
KT603Б, KT603Г не менее	60
KT603Е	60 – 200

при $I_E = 350 \text{ mA}$ 2T603И не менее 20

типовое значение 50*

при $T = 213 \text{ K}$, $I_E = 150 \text{ mA}$.

2T603A, 2T603Б	8 – 80
2T603Б, 2T603Г	20 – 180
2T603И не менее	8
при $T = 398 \text{ K}$, $I_E = 150 \text{ mA}$.	
2T603A, 2T603Б	20 – 180
2T603Б, 2T603Г	60 – 400
2T603И не менее	20

Время рассасывания при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА:	
2T603A, 2T603Б, 2T603B, 2T603Г, 2T603И не более	70 нс
типовое значение	40* нс
KT603A, KT603Б, KT603B, KT603Г, KT603Д, KT603Е не более	100 нс
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_Э = 30$ мА, $f = 5$ МГц не более	400 пс
типовое значение	25* пс
Граничная частота передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_Э = 30$ мА, не менее	200 МГц
типовое значение	370* МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ} = 10$ В, $f = 5$ МГц не более	15 пФ
типовое значение	3* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$, $f = 5$ МГц не более	40 пФ
типовое значение	35* пФ
Обратный ток коллектора, не более	
при $T = 298$ К при $U_{КБ} = 30$ В	
2T603A, 2T603Б, 2T603И	3 мкА
KT603A, KT603Б	10 мкА
при $U_{КБ} = 15$ В	
2T603B, 2T603Г	3 мкА
KT603B, KT603Г	5 мкА
при $U_{КБ} = 10$ В KT603Д, KT603Е	1 мкА
при $T = 398$ К	
при $U_{КБ} = 24$ В 2T603A, 2T603Б, 2T603И	60 мкА
при $U_{КБ} = 12$ В 2T603B, 2T603Г	60 мкА
Обратный ток эмиттера не более	
при $U_{ЭБ} = 3$ В 2T603A, 2T603Б, 2T603B, 2T603Г, 2T603A, KT603Б, KT603B, KT603Г, KT603Д, KT603Е	3 мкА
при $U_{БЭ} = 4$ В 2T603И	3 мкА

Пределевые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм

при $T_n \leq 343$ К

КТ603А, КТ603Б	30 В
--------------------------	------

КТ603В, КТ603Г	15 В
--------------------------	------

КТ603Д, КТ603Е	10 В
--------------------------	------

при $T_n \leq 373$ К

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	30 В
----------------------------------	------

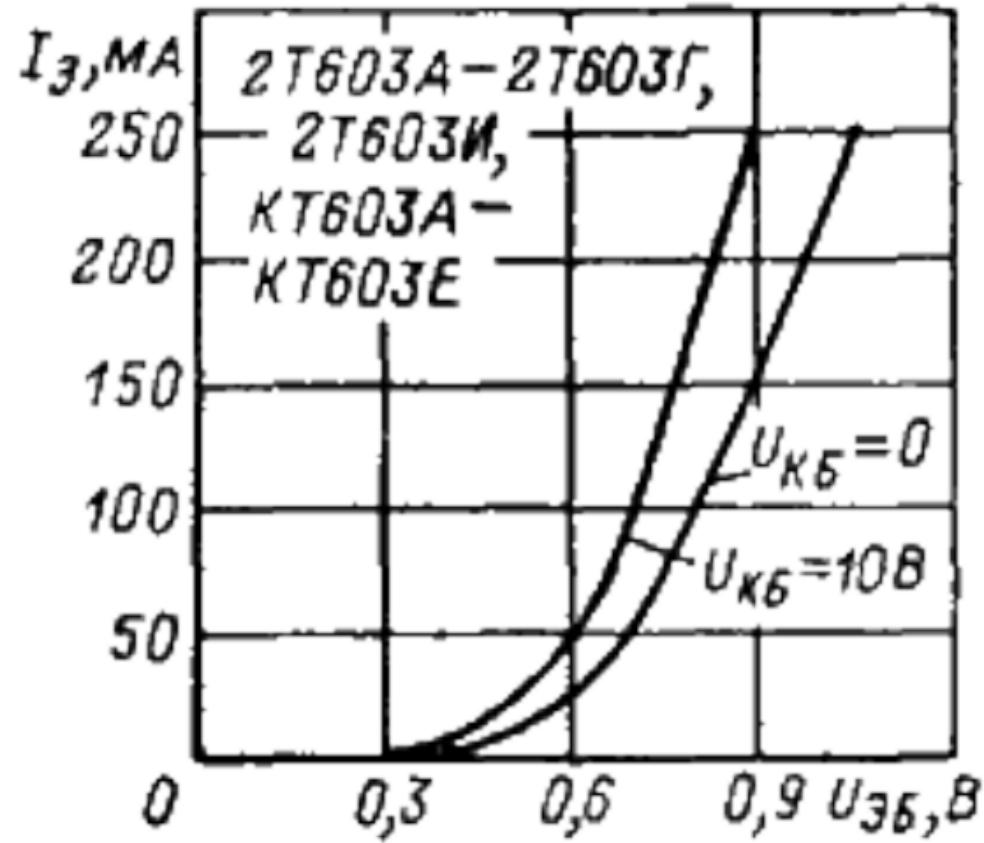
2Т603В, 2Т603Г	15 В
--------------------------	------

при $T_n = 393$ К

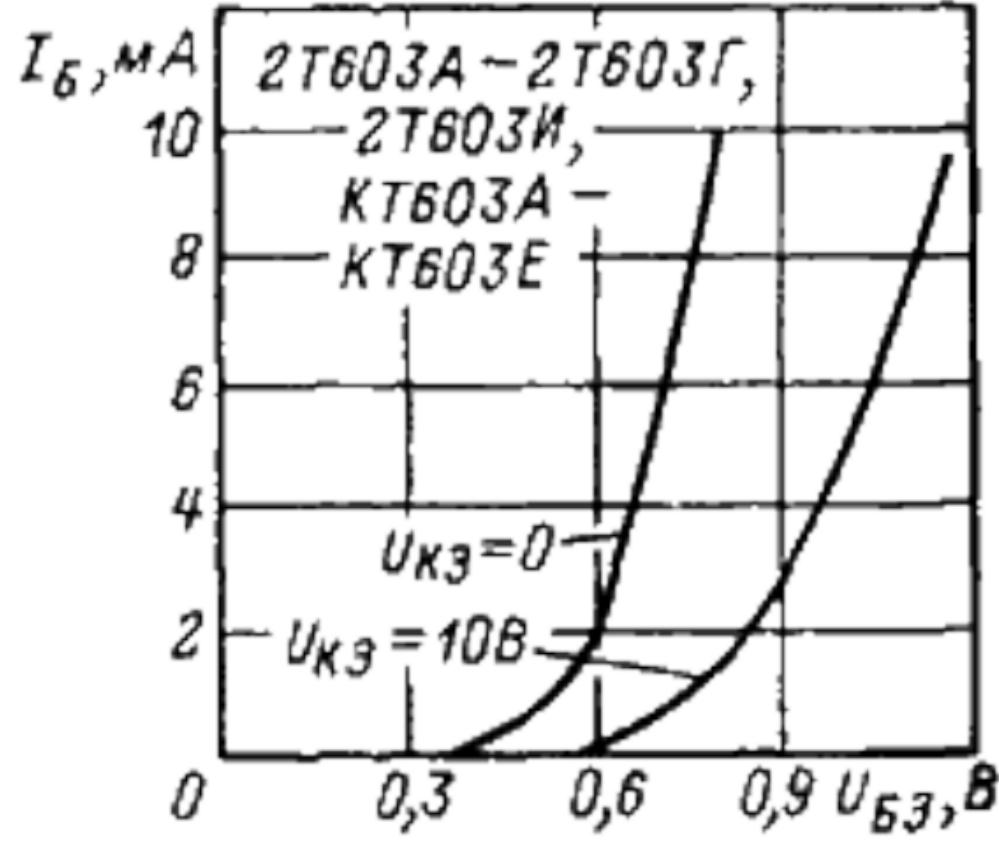
КТ603А, КТ603Б	15 В
--------------------------	------

КТ603В, КТ603Г	7,5 В
--------------------------	-------

КТ603Д, КТ603Е	10 В
при $T = 398$ К:	
2T603A, 2T603B, 2T603И	24 В
2T603B, 2T603Г	12 В
при $T = 423$ К:	
2T603A, 2T603B, 2T603И	18 В
2T603B, 2T603Г	9 В
Напряжение эмиттер-база.	
2T603A, 2T603B, 2T603B, 2T603Г	3 В
2T603И при $T_n \leq 343$ К	4 В
2T603И при $T_n = 398$ К	3 В
Постоянный ток коллектора	300 мА
Импульсный ток коллектора при $t_{\mu} \leq 10$ мкс, $Q \geq 10$	600 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
при $T \leq 323$ К	0,5 Вт
при $T = 358$ К КТ603A, КТ603B, КТ603B, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е и $T = 398$ К 2T603A, 2T603B, 2T603B, 2T603Г, 2T603И	0,12 Вт



Зависимость тока эмиттера от напряжения эмиттер-база.



Входные характеристики.